

# Silicon Diode

## **BY199**

Fast Rectifier

800V / 1,2A

# DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

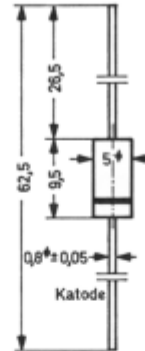
Source: ITT Intermetall Databook 73/74

## BY 196...BY 199

### Schnelle Silizium-Gleichrichter

Nennstrom	1,2 A
period. Spitzensperrspannung	100...800 V

Kunststoffgehäuse  $\approx$  DO-13  
 56 A 2 nach DIN 41 883  
 Gewicht ca. 0,6 g  
 Maße in mm



Grenzwerte	BY 196	BY 197	BY 198	BY 199	
period. Spitzensperrspannung $U_{RRM}$	100	200	400	800	V
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus-halbwellen ausgehend von $T_j = 25\text{ °C}$		$I_{FSM}$	70		A
Sperrschichttemperatur		$T_j$	150		°C
Betriebs- und Lagerungs-temperaturbereich		$T_U, T_S$	-40...+150		°C

Kennwerte			
Nennstrom in Einwegschaltung mit Widerstandslast bei $T_U = 50\text{ °C}$	$I_{FAV}$	1,2 1)	A
Durchlaßspannung bei $i_F = 3\text{ A}, T_j = 25\text{ °C}$	$u_F$	<1,3	V
Sperrstrom bei $U_{RRM}, T_j = 25\text{ °C}$	$I_R$	<10	$\mu\text{A}$
Durchlaßverzögerung bei $I_F = 100\text{ mA}$	$t_{tr}$	<1	$\mu\text{s}$
Sperrverzögerung beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	$t_{rr}$	<0,5	$\mu\text{s}$
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	$R_{thU}$	<60 1)	K/W

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.